

外為法の安全保障貿易管理に係る 改正（重要・新興品目等）

令和7年5月

経済産業省 貿易経済安全保障局

1 改正概要

- 我が国では、国際的な平和及び安全の維持のため、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、重要・新興技術として規制対象となる貨物の輸出や技術の提供について経済産業大臣の許可を受ける義務を課している。
- 国際的な協調の下、責任ある技術保有国として、国際的な状況を踏まえ、重要・新興技術の軍事転用防止を目的に、関連する特定の貨物及び技術を輸出管理の対象に追加し、併せて技術的な仕様の見直し等(ワッセナー・アレンジメント等での一致を踏まえたものを含む。)を行うため、外為法第25条第1項又は第48条第1項に基づく許可を要する貨物・技術について、「外国為替令」別表、「輸出貿易管理令」別表第1及び「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」及び関連通達の所要の改正を行う。

公布：令和7年3月28日（金）公布（省令・通達は4月3日（木）公布）

施行：令和7年5月28日（水）施行

- 政令：外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令（令和7年政令第102号）
- 省令：輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令（令和7年経済産業省第34号）
- 通達：輸出貿易管理令の運用について等の一部を改正する通達（令和7年4月3日付け輸出注意事項2025第9号）

2-1 輸出令(別表第1) 2の項(5):原子力

■ 「分離用・再生用装置」等の解釈の明確化【規定の明確化】

照射済み核燃料物質等の「分離用・再生用装置」につき「硝酸に対して耐食性を有する」こと、「中性子測定装置」を「制御装置」に含める等の明確化

● 運用通達 1-1(7)(イ)(解釈の表)2の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【2の項】</p> <p>(5) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置</p>	<p>第一条(略)</p> <p>五 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置</p>	<p>「分離用若しくは再生用に設計した装置」</p> <p>放射線を照射した核燃料物質、核原料物質(以下「照射済み核燃料物質等」という。)の再処理の過程において照射済み核燃料物質等と接触する装置</p> <p>処理の過程と通常の状態において照射済み核燃料物質等と接触する装置並びに次のいずれかに該当するものをいう。</p> <p>次のいずれかに該当するものを含む。</p> <p>イ～ハ(略)</p> <p>ニ 照射済み核燃料物質等の再処理工場で使用するため、硝酸に対して耐食性を有するように使用されるように特に設計又は製造された保管又は貯蔵の容器</p> <p>ホ 照射済み核燃料物質等の再処理工場で自動プロセス制御システムと統合及び使用されるように特に設計又は製造された中性子測定装置</p> <p>「貨物等省令第1条第五号中の制御装置」</p> <p>照射済み核燃料物質等の処理の過程を直接制御することのできる装置及び照射済み核燃料物質等の再処理のモニター又は制御のために特に設計又は製造されたプロセス制御装置を含む。</p> <p>次のいずれかに該当するものを含む。</p> <p>イ 照射済み核燃料の再処理工場で自動プロセス制御システムと統合及び使用されるように特に設計又は製造された中性子測定装置</p> <p>ロ 照射済み核燃料物質等の再処理のモニター又は制御のために特に設計又は製造されたプロセス制御装置</p>

2-2 輸出令(別表第1) 2の項(10):原子力

■ 「蒸留塔」の仕様の改正【規制の強化】

「蒸留塔」に係る仕様（材料、温度、圧力）を改正

- **貨物等省令** 第1条 第10号
- **運用通達** 1-1 (7) (イ) (解釈の表) 2の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【2の項】</p> <p>(10) 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置</p>	<p>第一条 (略)</p> <p>十 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ (略)</p> <p>ロ 重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であつて、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)</p> <p>(一) 削除</p> <p>(二) 低温で用いられる蒸留塔であつて、次の1から4までの全てすべてに該当するもの</p> <p>1 オーステナイト系ステンレス鋼又はこれと同等の材料細粒ステンレス鋼であつて、零下二五八度以上零下二三八度以下の温度範囲において水素ぜい性のないものを用いたもの</p> <p>2 (略)</p> <p>3 温度が零下二五八度以上零下二三八度以下で用いることができるように設計したもの</p> <p>4 〇・一〇五メガパスカル以上一五メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの</p> <p>(三) 真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充填充填物であつて、化学的にぬれ性を改善する処理を行ったりん青銅製のもののうち、メッシュ状のもの</p> <p>(四)~(六) (略)</p>	<p>細粒ステンレス鋼:(略)</p> <p>「貨物等省令第1条第十号ロ(二)中の同等の材料」</p> <p>次のいずれかに該当するものを含む。</p> <p>イ アルミニウム</p> <p>ロ アルミニウム合金</p> <p>ハ 銅合金</p> <p>ニ ニッケル合金</p> <p>ホ チタン合金</p> <p>充填充填物:充填充填物塔に充填充填物する物体をいう。</p>

2-3 輸出令(別表第1) 2の項(17):原子力

■ ロータに用いられる「構造材料」の仕様の改正【規制の強化】

ガス遠心分離機のロータの仕様（内径「400mm→650mm未満」、厚さ「12mm以下」追加）を改正

● 貨物等省令 第1条 第22号

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【2の項】</p> <p>(17) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)</p> <p>2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品</p>	<p>第一条 (略)</p> <p>二十二 ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ (略)</p> <p>ロ 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であつて、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一)～(三) (略)</p> <p>(四) (一)に該当する繊維又は(三)に該当するプリプレグ(炭素繊維を使用したものに限る。)を用いた円筒形の成型品であつて、内径が七五ミリメートル超六五〇 〇ミリメートル未満、かつ、厚さが一ニミリメートル以下のもの</p> <p>ハ・ニ (略)</p>	

2-4 輸出令(別表第1) 2の項(49):原子力

■ 「白金触媒」の仕様の改正【規制の強化】

白金触媒の仕様（疎水性の触媒であること等）を改正

- 輸出令別表第1 2の項(49)
- 貨物等省令 第1条 第59号

輸出令	貨物等省令	運用通達
【2の項】 (49) 水重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒	第一条（略） 五十九 水重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造(精製を含む。)するための白金を用いた疎水性の触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの	

2-5 輸出令(別表第1) 3の項(1):化学兵器

■ 「ジプロピルアミン」の追加【規制の強化】

化学製剤の原料物質として「ジプロピルアミン」を追加

● 貨物等省令 第2条 第1項 第1号

輸出令	貨物等省令	運用通達
【3の項】 (1) 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの	第二条 (略) 一 軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるもの イ～イイ (略) イロ ジプロピルアミン	

2-6 輸出令(別表第1) 3の項(2):化学兵器

■ 「空気中の物質を検知する装置」の仕様の改正【規制の明確化】

「空気中の物質を検知する装置」の仕様を改正した。これにともない、関連する運用通達の解釈の追加をした。

- **貨物等省令** 第2条 第2項 第11号
- **運用通達** 1-1(7)(イ)(解釈の表)3の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
【3の項】 (2) 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの 11 空気中の物質を検知する装置又はその部分品	第二条(略) 2(略) 十一 空気中の物質を検知する装置であつて、次のいずれかに該当するもの イ 前項に掲げるものについて空気中に おいて検知できる最小検出限界 おける濃度が一立方メートル当たり0・三ミリグラム未満 であつても検知することができるもの であり、かつ、連続して使用するよう設計したもの ロ(略)	「最小検出限界」 空気中の物質を検知する装置の最小検出限界は、ブランク試料測定時に当該装置の信号の標準偏差の3倍を超える信号を生成するために必要な分析物の検出可能な最低限の濃度をいう。 ただし、デッドバンド又はプログラムによってゼロサプレースされた検出装置の場合は、検出装置により生成された最低濃度値(読み取り値)を最低検出濃度とする。

2-7 輸出令(別表第1) 3の2の項(1):生物兵器

■ 「ネオサキシトキシン」の追加とワクチンの解釈【規制の強化】

毒素として「ネオサキシトキシン」を追加。

- 貨物等省令 第2条の2 第1項 第3号
- 運用通達 1-1 (7) (イ) (解釈の表) 3の2の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【3の2の項】</p> <p>(1) 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの</p>	<p>第二条の二 (略)</p> <p>三 毒素(免疫毒素を除く。)であつて、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素(アルファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン又はイオタの毒素に限る。)、HT-2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素(腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素)、ゴニオトキシン、コノトキシン、ジアセトキシスシルペノール、志賀毒素、T-2トキシン、テロドトキシン、ネオサキシトキシン、ノジュラリン、パリトキシン、ビスカミン、ブレベトキシン、ボツリヌス毒素、ボルケンシン、マイクロシスチン又はモデシン</p>	<p>「ワクチン」</p> <p>医療用のワクチンを含む。人又は動物の疾病を防止するため、接種により免疫の機能を促進するためのものであつて、製造者又は使用者が所在する国の規制当局の薬剤規格をもって認可を受けている医薬品で、販売又は臨床試験(獣医学的臨床試験含む。)の実施の認証を受けているものをいう。</p>

2-8 輸出令(別表第1) 5の項(18):先端材料

■ 繊維等の製造装置の仕様の改正【規制の緩和】

繊維等の製造装置の仕様（対象となる繊維の限定）を改正

- **貨物等省令** 第4条 第4号
- **運用通達** 1-1 (7) (イ) (解釈の表) 5の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【5の項】</p> <p>(18) 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくは(16)に掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(2、4及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)</p>	<p>第四条 (略)</p> <p>四 繊維又はこれを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品 第二号、第十五号又は第十四条第一号に該当するものの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品(第三条第十一号に該当するものを除く。)</p> <p>イ～ハ (略)</p> <p>ニ 第十五号に該当する繊維を製造するために特に設計又は改造した繊維の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一)～(四) (略)</p> <p>ホ ホットメルト方式によりプリプレグを製造するために特に設計又は改造したを用いて第十五号ホに該当するプリプレグを製造する装置</p> <p>へ・ト (略)</p>	<p>「ホットメルト方式」 加圧及び加熱により、フィルムや紙等のキャリア基材にあらかじめラミネートされた樹脂を繊維に含浸させる工程をいう。</p>

2-9 輸出令(別表第1) 5の項(19):先端材料

■ 「五ふっ化よう素」の追加【規制の強化】

「五ふっ化よう素」を追加

- 輸出令別表第1 5の項(19)
- 貨物等省令 第4条 第16号

輸出令	貨物等省令	運用通達
【5の項】 (19) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニログアニジン又は五ふっ化よう素(2及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)	第四条(略) 十六 粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素であって、ほう素の重量比による純度が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、粒子の径が六〇マイクロメートル以下のほう素合金であって、ほう素の重量比が八五パーセント以上のもの若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニログアニジン又は五ふっ化よう素	

2-10 外為令(別表) 5の項(8):先端材料

■ 「赤外線」の追加【規制の明確化】

「電波の吸収材」に「赤外線」も含まれることを明確化

- 外為令別表 5の項(8)
- 貨物等省令 第17条 第7項

外為令	貨物等省令	役務通達
【5の項】 (8) 電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)	第十七条(略) 7 外為令別表の五の項(八)の経済産業省令で定める技術は、第十四条第二号に該当する電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。	

2-11 外為令(別表) 6の項(6):材料加工

■ 「高温コーティング技術」の追加【規制の強化】

セラミック複合材料に係る「高温コーティング技術」を追加

- 外為令別表 6の項(6)
- 貨物等省令 第18条 第6項
- 役務通達 2 別紙1(解釈の表) 6の項

外為令	貨物等省令	役務通達
【6の項】 <u>(6)被覆したセラミックの複合材料の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの</u>	第十八条(略) <u>6 外為令別表の六の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次の各号の全てに該当するコーティングシステムの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。</u>	<u>「貨物等省令第18条第6項に掲げる技術」</u> <u>外為令1の項から15の項までの中欄に掲げるものを除く。</u> <u>「コーティングシステム」</u> <u>基材上に堆積された材料が一層以上の層(例えば、ボンドコート又はトップコート)によって構成されたものをいう。</u>

2-12 輸出令(別表第1) 6の項(10):材料加工

■ 「金属積層造形装置」の追加【規制の強化】

「金属積層造形装置・その部分品」を追加

- 輸出令別表第1 6の項(10)
- **貨物等省令** 第5条 第12号 ㍀
- 運用通達 1-1(7)(イ)(解釈の表)6の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【6の項】</p> <p>(10) 積層造形用の装置又はその部分品</p>	<p>第五条 (略)</p> <p><u>十二 金属若しくは合金の部品を製造するために設計された積層造形用の装置であって、次のイからニまでの全てに該当するもの又はそのために特に設計した部分品</u></p> <p><u>イ 次のいずれかの熱源を有するもの</u></p> <p><u>(一)レーザー</u></p> <p><u>(二)電子ビーム</u></p> <p><u>(三)電気放電</u></p> <p><u>㍀ 次のいずれかの制御されたプロセス環境を有するもの</u></p> <p><u>(一)不活性ガス</u></p> <p><u>(二)一〇〇パスカル以下の真空</u></p> <p><u>ハ 次のいずれかの同軸構成又は近軸構成であるインプロセス監視装置を有するもの</u></p> <p><u>(一)電子式のカメラであって、三八〇ナノメートル超一四、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの</u></p> <p><u>(二)パイロメーターであって、一、〇〇〇度以上の温度を計測するために設計したもの</u></p> <p><u>(三)放射計又は分光機であって、三八〇ナノメートル超三、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの</u></p> <p><u>ニ ハに該当するインプロセス監視装置からのフィードバックに応じて、造形中に熱源のパラメータ、製造経路又は機器設定を修正するように設計された閉ループ制御が可能なもの</u></p>	<p><u>「同軸校正」</u></p> <p><u>軸上構成又はインライン構成ともいう。</u></p> <p><u>レーザー光と同一の光路上に搭載される1つ以上のセンサーに関連する。</u></p> <p><u>センサーの視野は、レーザー、電子ビーム又は電子放電の移動基準フレームに固定され、ビルドプロセスを通じてレーザー、電子ビーム又は電子放電と同じスキャン軌道を移動する。</u></p> <p><u>「近軸構成」</u></p> <p><u>レーザー、電子ビーム又は電気放電の発生源の構成品に対して物理的に搭載される又は統合される1つ以上のセンサーに関連する。</u></p> <p><u>センサーの視野は、レーザー、電子ビーム又は電子放電の移動基準フレームに固定され、ビルドプロセスを通じてレーザー、電子ビーム又は電子放電と同じスキャン軌道を移動する。</u></p> <p><u>「インプロセス監視」</u></p> <p><u>インシチュプロセスモニタリングともいう。</u></p> <p><u>メルトプールからの電磁放射又は熱放射を含む積層造形プロセスの観察及び測定に関連する。</u></p>

2-13 輸出令(別表第1) 7の項(1):エレクトロニクス

■ 「先端ICチップ」の追加【規制の強化】

「先端ICチップ」を追加

- **貨物等省令** 第6条 第1号ヨ
- **運用通達** 1-1(7)(イ) (解釈の表) 7の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(1) 集積回路(4の項の中欄に掲げるものを除く。)</p>	<p>第六条(略)</p> <p>一 集積回路(モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路(シリコンオンサファイア集積回路を含む。)、光集積回路、三次元集積回路及びモノリシックマイクロ波集積回路を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p><u>ヨ 揮発性メモリを含まない他の集積回路との間の全ての入力及び出力にわたる双方向の転送速度の総計が六〇〇ギガバイト毎秒以上である集積回路であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらに該当するようにプログラムが可能なもの</u></p> <p><u>(一) 合計処理性能(TPP)が六、〇〇〇以上である機械語命令を実行するデジタルプロセッサユニットを一つ以上有するもの</u></p> <p><u>(二) (一)で指定された機械語命令の実行に寄与するユニットを除き、合計処理性能(TPP)が六、〇〇〇以上であるデジタル基本演算ユニットを一つ以上有するもの</u></p> <p><u>(三) 合計処理性能(TPP)が六、〇〇〇以上であるアナログ基本演算ユニットを一つ以上有するもの</u></p> <p><u>(四) (一)から(三)までのデジタルプロセッサユニットと基本演算ユニットの組み合わせであって、それらの合計処理性能(TPP)の総和が六、〇〇〇以上であるものを有するもの</u></p>	<p><u>「貨物等省令第6条第一号ヨ中の集積回路」</u> <u>グラフィカルプロセッサユニット(GPUs)、テンソルプロセッシングユニット(TPUs)、ニューラルプロセッサ、プロセッサ内蔵メモリ、ビジョンプロセッサ、テキストプロセッサ、コプロセッサ又はアクセラレータ、適応型プロセッサ、フィールドプログラマブルロジックデバイス(FPLDs)及び特定用途向け半導体(ASICs)を含む。</u></p> <p><u>「合計処理性能(TPP)」</u> <u>集積回路上の全てのプロセッサユニットにわたって演算ビット長にテラ(1012)オペレーション毎秒(TOPS)で測定された処理性能を乗じたもの。</u> <u>例えば、それぞれ16ビット演算で200TOPSの性能を持つ2つのデジタルプロセッサユニットを備えた集積回路のTPPIは6400(2プロセッサ×200TOPS×16ビット=6400)となる。</u> <u>貨物等省令第6条第一号ヨ(三)において、各アナログ基本演算ユニットのTPPIは、TOPSで表される処理性能に8を乗じたものとする。</u> <u>TOPS値は、全ての演算ユニットが同時に動作している場合に理論的に可能な最大値とする。</u> <u>TOPS値と総計双方向転送レートの総計値は、メーカーがそのチップのマニュアル又はパンフレットで主張する最高値を用いる。</u> <u>演算のビット長は、その演算の入力又は出力の最大ビット長と等しいとする。さらに、プロセッサユニットが異なるビット長×TOPS値を実現する演算用に設計されている場合は、最大ビット長×TOPS値を使用しなければならない。</u> <u>疎行列と密行列の両方の処理を提供する演算ユニットは、TOPS性能実力値は、密行列の処理の性能実力値とする。(例えば、スパース性を利用した高速化演算処理は行わないものとする。)</u></p>

2-13 輸出令(別表第1) 7の項(1):エレクトロニクス

<続き>

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(1) 集積回路(4の項の中欄に掲げるものを除く。)</p>	<p>(続き)</p>	<p><u>「基本演算ユニット」</u> <u>0個以上の変更可能な重みを含み、1つ以上の入力を受け取り、1つ以上の出力を生成するものをいう。</u> <u>演算ユニットは、N個の入力に基づいて出力が更新されるたびに$2N-1$の演算を実行するものであり、処理要素に含まれる変更可能なそれぞれの重みは入力としてカウントされる。</u> <u>各入力、重み及び出力は、1つ以上のビットを使用して表されるアナログ信号レベル又はスカラーデジタル値である場合がある。</u> <u>このような演算ユニットには、人工ニューロン、積和演算(MAC)ユニット、浮動小数点ユニット(FPUs)、アナログ乗算器ユニット、メモリスタ、スピントロニクス若しくはマグノニクスを使用した演算ユニット、フォトニクス若しくは非線形光学を使用した演算ユニット、アナログ若しくはマルチレベルの不揮発性重み値を使用する演算ユニット、多値メモリ若しくはアナログメモリを使用した演算ユニット、多値理論のユニット又はスパイクングユニットを含む。</u></p>

2-14 輸出令(別表第1) 7の項(2):エレクトロニクス

■ 「パラメトリック信号増幅器」の追加【規制の強化】

「パラメトリック信号増幅器(極低温アンプ)」を追加

- **貨物等省令** 第6条 第2号ヨ
- **運用通達** 1-1(7)(イ)(解釈の表)7の項

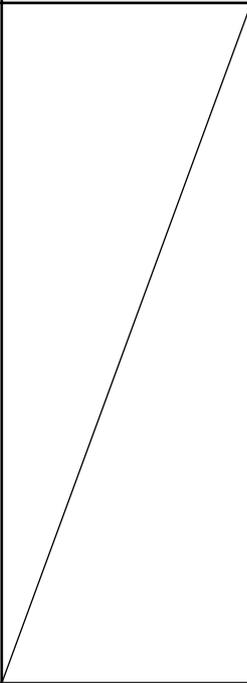
輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(2) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品</p>	<p>第6条(略)</p> <p>ニ マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p><u>ヨ パラメトリック信号増幅器であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの</u></p> <p><u>(一) 零下二七二・一五度未満の温度で作動するように設計したもの</u></p> <p><u>(二) 動作周波数がニギガヘルツ超一五ギガヘルツ以下で作動するように設計したもの</u></p> <p><u>(三) 動作周波数がニギガヘルツ超一五ギガヘルツ以下かつ零下二七二・一五度の温度において、雑音指数が〇・〇一五デシベル未満のもの</u></p>	<p><u>「貨物等省令第6条第2号ヨ中のパラメトリック信号増幅器」</u></p> <p><u>超電導進行波パラメトリック信号増幅器を含む。</u></p>

2-15 輸出令(別表第1) 7の項(2):エレクトロニクス

■ 「ハーモニックミクサ」等の仕様の改正【規制の強化】

ハーモニックミクサ・コンバータの仕様（周波数帯域「90ギガヘルツ→110ギガヘルツ」等）を改正

● 貨物等省令 第6条 第2号 リ

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(2) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品</p>	<p>第六条（略）</p> <p>ニ マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ〜チ（略）</p> <p>リ ハーモニックミクサ又はコンバータであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) スペクトラムアナライザの周波数帯域を一一〇九〇ギガヘルツ超に拡張するように設計したもの</p> <p>(二) 信号発生器の動作範囲を拡張するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>1 周波数帯域が一一〇九〇ギガヘルツを超えるもの</p> <p>2 周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超一一〇九〇ギガヘルツ以下であって、出力が一〇〇ミリワット(二〇ディービーエム)を超えるもの</p> <p>(三) ネットワークアナライザの動作範囲を拡張するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>1 (略)</p> <p>2 周波数帯域が四三・五ギガヘルツ超一一〇九〇ギガヘルツ以下であって、出力が二〇〇三〜六三ミリワット(二〇五ディービーエム)を超えるもの</p> <p>3 周波数帯域が九〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下であって、出力が一ミリワット(〇ディービーエム)を超えるもの</p> <p>(四) (略)</p>	

2-16 外為令(別表第1) 7の項(3):エレクトロニクス

■ ソフトウェアの追加【規制の強化】

・「先端パッケージング用のECADプログラム」「マルチパターンニング技術を用いた集積回路製造用のECADプログラム」「計算機リソグラフィプログラム」を追加

- 外為令別表第1 7の項(3)
- **貨物等省令** 第19条 第3項 第9号~第11号
- **役務通達** 2 別紙1(解釈の表) 7の項

輸出令	貨物等省令	役務通達
<p>【7の項】</p> <p>(3) 集積回路の設計又は製造に係る技術であって、経済産業省令でさだめるもの((1)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)</p>	<p>第十九条 (略)</p> <p>3 (略)</p> <p><u>九 複数のチップをマルチチップ集積回路に統合するために設計した電子コンピュータ支援設計プログラムであって、次の全てに該当するもの</u></p> <p><u>(一) フロアプランニングを有するもの</u></p> <p><u>(二) チップとパッケージの協調設計又は協調シミュレーションを有するもの</u></p> <p><u>十 マルチパターンニングを使用した集積回路を設計し、又は製造するために設計し、又は改造した電子コンピュータ支援設計プログラム</u></p> <p><u>十一 深紫外リソグラフィのマスク又はレチクル上のパターンを設計し、又は製造するために設計し、又は改造した計算機リソグラフィ用のプログラム</u></p>	<p><u>「貨物等省令第19条第3項第九号中のマルチチップ」マルチダイ及びマルチチップレットを含む。</u></p> <p><u>「貨物等省令第19条第3項第十一号中の計算機リソグラフィ」パターン、プロセス又はシステム条件の範囲にわたり、リソグラフィプロセスのイメージング性能を予測し、修正し、最適化し、又は検証するためにコンピュータモデリングを使用するものをいう。</u></p>

2-17 輸出令(別表第1) 7の項(12):エレクトロニクス

■ 「信号発生器」の仕様の改正【規制の強化】

信号発生器の仕様（周波数帯域「90ギガヘルツ→110ギガヘルツ」）を改正

● 貨物等省令 第6条 第13号

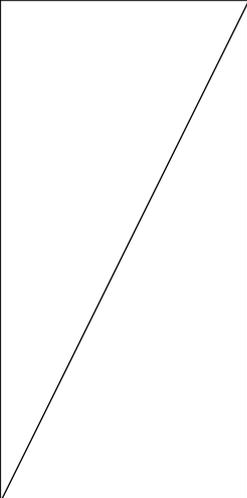
輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(12) 信号発生器</p>	<p>第六条（略）</p> <p>十三 信号発生器であって、次のいずれかに該当するもの（二以上の水晶発振器の周波数を加算した値、減算した値又はこれらの値を逡倍した値によって出力周波数を規定する装置を除く。）</p> <p>イ（略）</p> <p>ロ 四三・五ギガヘルツ超 一一〇九〇ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、出力一〇〇ミリワット（二〇ディービーエム）を超えるもの</p> <p>ハ 次のいずれかに該当するもの</p> <p>（一）～（五）（略）</p> <p>（六）七五ギガヘルツ超 一一〇九〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの</p> <p>ニ 搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次のいずれかに該当するもの</p> <p>（一）三・ニギガヘルツ超 一一〇九〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇ヘルツ以上一〇キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの</p> $20\log 10(\text{メガヘルツで表した動作周波数}) - 20\log 10(\text{ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり}) - 126$ <p>（二）三・ニギガヘルツ超 一一〇九〇ギガヘルツ以下のいずれかの出力周波数帯域で、動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇キロヘルツ超一〇〇キロヘルツ以下のいずれかの周波数帯域において、次に掲げる式により算定した値未満のもの</p> $20\log 10(\text{メガヘルツで表した動作周波数}) - 206$ <p>ホ デジタルベースバンド信号をベクトル変調する機能を有するもので、ベクトル変調帯域幅が次のいずれかに該当するもの</p> <p>（一）～（三）（略）</p> <p>（四）七五ギガヘルツ超 一一〇九〇ギガヘルツ以下の出力周波数帯域で、五・〇ギガヘルツを超えるもの</p> <p>ヘ 最大出力周波数が 一一〇九〇ギガヘルツを超えるもの</p>	

2-18 輸出令(別表第1) 7の項(13):エレクトロニクス

■ 「スペクトラムアナライザー」の仕様の改正【規制の強化】

周波数分析器のスペクトラムアナライザーの仕様（周波数帯域等）を改正

● 貨物等省令 第6条 第12号

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(13) 周波数分析器</p>	<p>第六条（略）</p> <p>十二 スペクトラムアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ（略）</p> <p>ロ 四三・五ギガヘルツ超一一〇兆ギガヘルツ以下のいずれかの周波数帯域で、表示平均ノイズレベルがマイナス一六 〇五ディービーエム毎ヘルツ未満のもの</p> <p>ハ 一一〇兆ギガヘルツを超える周波数を分析することができるもの</p> <p>ニ 次の（一）及び（二）に該当するもの</p> <p>（一）実時間帯域幅が五二〇七メガヘルツを超えるもの</p> <p>（二）次のいずれかに該当するもの</p> <p>1 △一五マイクロ秒以下の長さの信号を、ギャップ又は窓効果による全振幅からの減衰が三デシベル未満で、一〇〇パーセントの確率で検出するもの</p> <p>2 周波数マスクトリガー機能を有するものであって、△一五マイクロ秒以下の長さの信号を一〇〇パーセントの確率で捉えるもの</p>	

2-19 輸出令(別表第1) 7の項(14):エレクトロニクス

■ 「ネットワークアナライザー」の仕様の改正【規制の強化】

ネットワークアナライザーの仕様（動作周波数帯域、出力等）を改正

● 貨物等省令 第6条 第14号

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(14) ネットワークアナライザー</p>	<p>第六条（略）</p> <p>十四 ネットワークアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 四三・五ギガヘルツ超一一〇九〇ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が一〇〇三ミリワット(二〇五ディービーエム)を超えるもの</p> <p>ロ 削除</p> <p>九〇ギガヘルツ超一〇ギガヘルツ以下のいずれかの動作周波数帯域において、出力が一ミリワット(〇ディービーエム)を超えるもの</p> <p>ハ 五〇ギガヘルツ超一一〇ギガヘルツ以下の周波数帯域における非線形ベクトルの計測機能を有するもの(イ又はロに該当するものを除く。)</p>	

2-20 輸出令(別表第1) 7の項(15の3):エレクトロニクス

■ 「極低温冷却装置」の追加【規制の強化】

「極低温冷却装置・その部分品」を追加

- 輸出令別表第1 7の項(15の3)
- **貨物等省令** 第6条 第16号の3

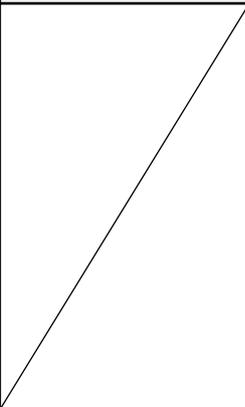
輸出令	貨物等省令	運用通達
【7の項】 <u>(15の3)極低温用に設計した冷却装置又はその部分品</u>	第六条(略) <u>十六の三 極低温用の冷却装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの</u> <u>イ 零下二七三・〇五度以下の温度において、四八時間超にわたって、六〇〇マイクロワット以上の冷凍出力を供給する定格のもの</u> <u>ロ 二段式のパルスチューブ冷凍機であって、温度を零下二六九・一五度未満に維持するものであり、かつ、零下二六八・九五度以下の温度において、一・五ワット以上の冷凍出力を供給する定格のもの</u>	/

2-21 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「エピタキシャル成長装置」の仕様の改正【規制の強化】

エピタキシャル成長装置の仕様（化合物半導体の元素に「酸素」を追加）を改正

● 貨物等省令 第6条 第17号 イ

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条（略）</p> <p>十七 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置（ホ及びレにおいて「半導体製造装置」という。）若しくは試験装置 若しくは集積回路の製造用のマスク若しくはレチナルであつて、次のいずれかに該当するもの 又はこれらの部分品若しくは附属品 （次号に該当するものを除く。）</p> <p>イ 結晶のエピタキシャル成長装置であつて、次のいずれかに該当するもの（ウに該当するものを除く。）</p> <p>（一）（略）</p> <p>（二） 有機金属化学的気相成長反応炉であつて、アルミニウム、ガリウム、インジウム、砒^(v)素、りん、アンチモン、酸素又は窒素のいずれか二以上の元素を有する化合物半導体をエピタキシャル成長させるもの</p> <p>（三）（略）</p>	

2-22 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「異方性ドライエッチング装置」の仕様の改正【規制の強化】

- ・ 高速ガス切替弁の切り替え時間を300ミリ秒から500ミリ秒へ変更
- ・ 静電チャックの個別温度制御領域数を20から10へ変更

- 輸出令別表第1 7の項(16)
- 貨物等省令 第6条 第17号 カ

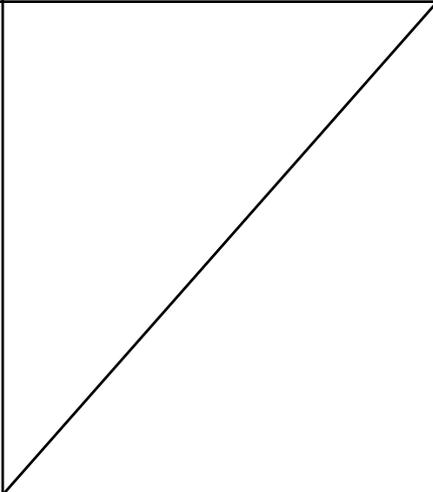
輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p>カ ドライエッチング用に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) (略)</p> <p>(二) 異方性ドライエッチング用に設計し、又は改造した装置であって、次の全てに該当するもの (ア(一)又はサに該当するものを除く。)</p> <p>1 (略)</p> <p>2 切替時間が ≧300ミリ秒 ≦500ミリ秒 未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの</p> <p>3 静電チャック(個別に温度を制御することができる領域を ≧100 以上有するものに限る。)を有するもの</p>	

2-23 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「成膜装置」の仕様の改正【規制の明確化】

- ・水素、水素と窒素の混合物、アンモニアである旨を明確化
- ・プラズマによる表面処理を行うことを明確化

- 輸出令別表第1 7の項(16)
- 貨物等省令 第6条 第17号 レ(三)

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは付属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p>レ 半導体製造装置のうち、成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一)・(二) (略)</p> <p>(三) 単一のチャンバー内での複数の工程によって金属のコンタクト層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの((二)に該当するものを除く。)</p> <p>1 (略)</p> <p>2 水素、水素と窒素の混合物又はアンモニアとの混合物を含む。を用いたプラズマによるり表面処理を行う工程を有するもの</p>	

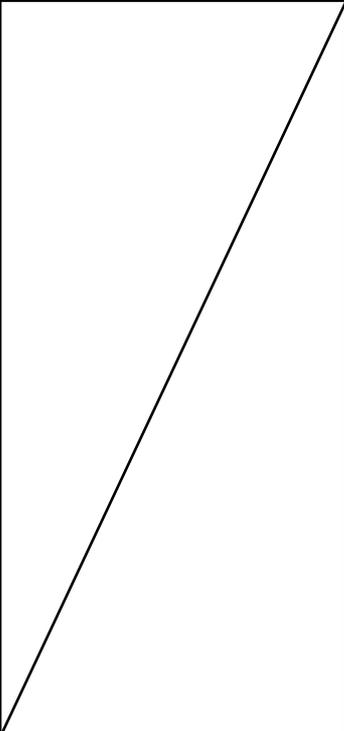
2-24 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「成膜装置」の仕様の改正【規制の強化】

・真空状態又は不活性ガスの環境を維持する条件を削除。

● 輸出令別表第1 7の項(16)

● 貨物等省令 第6条 第17号 レ(四)、ソ、ツ

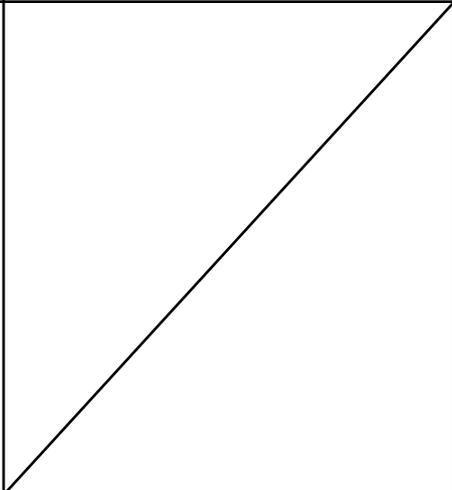
輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p>レ 半導体製造装置のうち、成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一)～(三) (略)</p> <p>(四) 半導体製造装置であって、複数のチャンバー又はステーション内での複数の工程によって成膜するものであり、かつ、複数の工程間において〇・〇パスカル以下の真空状態又は不活性の環境を維持することができるように設計したもの(以下「特定半導体製造装置」という。)のうち、次に掲げる全ての工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもの((二)に該当するものを除く。)</p> <p>1～3 (略)</p> <p>ソ <u>特定半導体製造装置のうち、〇・〇パスカル以下の真空状態又は不活性ガスの環境において</u>金属の層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。)</p> <p>(一)・(二) (略)</p> <p>ツ <u>特定半導体製造装置のうち、〇・〇パスカル以下の真空状態又は不活性ガスの環境において</u>金属の層を成膜するように設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの(レ(二)に該当するものを除く。)</p> <p>(一)・(二) (略)</p>	

2-25 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「エピタキシャル成長装置」の仕様の改正【規制の強化】

- ・シリコン又はシリコンゲルマニウムにおいて、「炭素を添加したものを含む」を削除
- ・真空状態又は不活性の環境を維持する条件を削除。

- 輸出令別表第1 7の項(16)
- 貨物等省令 第6条 第17号 ウ

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p>ウ シリコン(炭素を添加したものを含む。)又はシリコンゲルマニウム(炭素を添加したものを含む。)のエピタキシャル成長用に設計した装置であって、次の全てに該当するもの</p> <p>(一) 複数のチャンバーを有し、かつ、複数の工程間において〇〇パスカル以下の真空状態又は水と酸素の分圧が〇〇パスカル未満の不活性な環境を維持することができるもの</p> <p>(一) (一) 前処理としてウエハーの表面を清浄化するために設計したチャンバーを一以上有するもの</p> <p>(二) (二) エピタキシャル成長の動作温度が六八五度以下であるもの</p>	

2-26 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「成膜装置」の仕様の改正【規制の緩和等】

- ・カーボンハードマスクの仕様のうち、厚さの値を改正。
- ・カーボンハードマスクの仕様のうち、応力の条件から密度の条件へ改正。

- 輸出令別表第1 7の項(16)
- 貨物等省令 第6条 第17号 中

輸出令	貨物等省令	運用通達
【7の項】 (16)半導体素子、 集積回路若しく は半導体物質の 製造用の装置若 しくは試験装置 又はこれらの部 分品若しくは附 属品	第六条 (略) 十七 (略) 中 厚さが 二マイクロメートル 〇〇ナノメートル超であり、かつ、密度が一立方センチメートル当たり 一・七グラム 超応力が四五〇メガパスカル未満のカーボンハードマスクをプラズマを用いた化学的 気相成長法により成膜するように設計した装置	

2-27 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「プラズマドーピングイオン注入装置」の追加【規制の強化】

・ 「プラズマドーピングイオン注入装置」を追加

- 輸出令別表第1 7の項(16)
- 貨物等省令 第6条 第17号 コ
- 運用通達 1-1(7)(イ)(解釈の表)7の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p><u>コ プラズマドーピング用に設計されたイオン注入装置のうち、次の全てに該当するもの</u></p> <p><u>(一) 高周波の出力の電源を一以上有するもの</u></p> <p><u>(二) パルス直流電源を一以上有するもの</u></p> <p><u>(三) 少なくともN型又はP型のいずれかの不純物の注入が可能なもの</u></p>	<p><u>「貨物等省令第6条第十七号コ中のイオン注入装置」</u></p> <p><u>直径300ミリメートル未満のウエハー用に設計された装置を除く。</u></p>

2-28 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「露光装置のアップグレードのための装置」の追加【規制の強化】

・ 「露光装置のアップグレードのための装置」を追加

- 輸出令別表第1 7の項(16)
- **貨物等省令** 第6条 第17号 エ
- **運用通達** 1-1(7)(イ)(解釈の表)7の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p><u>エ 深紫外液浸フォトリソグラフィ装置において、又は、深紫外液浸フォトリソグラフィ装置とともに、次の全てを実施するように設計又は改造した装置</u></p> <p><u>(一) 次の全てに該当するもの</u></p> <p><u>1 深紫外液浸フォトリソグラフィ装置のナノメートルで表した光源の波長に0・二五を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値を四五以下に減少させるもの</u></p> <p><u>2 深紫外液浸フォトリソグラフィ装置の重ね合わせ精度を二・四ナノメートル以下にするもの</u></p> <p><u>(二) へ(一)2又は3に該当する露光装置の任意の時間間隔における一時間当たりのウエハーを処理する枚数を平均で一パーセント以上増加させるように設計又は改造したもの</u></p>	<p><u>「第6条第十七号エ(二)中のへ(一)2及び3に該当する露光装置」</u></p> <p><u>第6条第十七号エ(一)を用いることで、同号へ(一)2又は3に該当する性能を有する場合を含む。</u></p>

2-29 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「インプリントリソグラフィ装置」の追加【規制の強化】

・ 「インプリントリソグラフィ装置」を追加

- 輸出令別表第1 7の項(16)
- **貨物等省令** 第6条 第17号 テ

輸出令	貨物等省令	運用通達
【7の項】 (16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品	第六条 (略) 十七 (略) <u>テ インプリントリソグラフィ装置であって、四・〇ナノメートル以下の重ね合わせ精度を有するもの</u>	

2-30 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「エッチング装置」の追加【規制の強化】

- ・ 「エッチング装置」を追加
- 輸出令別表第1 7の項(16)
- **貨物等省令** 第6条 第17号 ア
- 運用通達 1-1(7)(イ) (解釈の表) 7の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p><u>ア エッチング用に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの</u></p> <p><u>(一) 異方性ドライエッチング用に設計した装置であって、次の全てに該当するもの</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1 ニ以上の独立した高周波の電源を有するもの</u> <u>2 ニ以上の独立したガスの供給源を有するもの</u> <u>3 ウエハーの厚みの不均一性を補正するためのプロセス均一性調整機能を有するもの</u> <u>4 シリコン貫通電極の露出工程の終点検出の機能を有するもの</u> <p><u>(二) 異方性エッチング用に設計した装置であって、誘電体の材料に対して、エッチングの幅に対する深さの比率が高い形状を形成することができるもののうち、次の全てに該当するもの(カ(二)、ヨ、タ、ア(一)又はサに該当するものを除く。)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1 エッチングの幅に対する深さの比率が三〇を超えるもの</u> <u>2 エッチングの幅の上面の寸法が四〇ナノメートル未満のもの</u> <p><u>(三) シリコン貫通電極を作るためのエッチングに用いるために設計した装置であって、次の全てに該当するもの(カ、ヨ、タ、ア(一)又はア(二)に該当するものを除く。)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>1 シリコンのエッチング速度が一分につき七マイクロメートルを超えるもの</u> <u>2 ウエハー内のエッチングの深さの不均一性が二パーセント以下のもの</u> <u>3 シリコン貫通電極のアスペクト比が一〇以上のもの</u> 	<p><u>「貨物等省令第6条第十七号ア(一)3中のプロセス均一性調整」</u> <u>研磨後のウエハーの厚さのばらつきを補正する工程をいう。</u></p> <p><u>「第十七号ア(二)中の異方性エッチング用に設計した装置」</u> <u>直径300ミリメートル未満のウエハー用に設計された装置を除く。</u></p> <p><u>「貨物等省令第6条第十七号ア(三)2中の深さの不均一性」</u> <u>深さの最大と最小の差を、深さの最大と最小の和で除して得た値をいう。</u></p>

2-31 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「パターンシェイピング装置」の追加【規制の強化】

- ・ 「パターンシェイピング装置」を追加
- 輸出令別表第1 7の項(16)
- 貨物等省令 第6条 第17号 テ
- 運用通達 1-1(7)(イ) (解釈の表) 7の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p><u>サ 極端紫外パターンシェイピング用に設計した装置(カ(一)、ヨ又はア(一)に該当するものを除く。)</u></p>	<p><u>「貨物等省令第6条第十七号サ中のパターンシェイピング」</u></p> <p><u>ウエハーに対し鉛直以外のある特定の方向に指向制御されたイオン、中性粒子、ラジカル、クラスター、光のいずれか1つ以上を用い、極端紫外リソグラフィを用いて生成されたパターンを再形成又はトリミングすることにより、全体的なパターンニングを改善するために使用される成膜又は除去プロセスをいう。</u></p>

2-32 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 成膜装置の追加【規制の強化】

・「成膜装置」を追加

- 輸出令別表第1 7の項(16)
- 貨物等省令 第6条 第17号 キ
- 運用通達 1-1(7)(イ)(解釈の表) 7の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16)半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p><u>キ 半導体製造装置のうち、成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの</u></p> <p><u>(一) タングステンの膜を物理的気相成長法により成膜する装置であって、イオンフラックス誘導用の電磁石を有し、アスペクト比を三以上の形状に対して成膜するために特別に設計したもの</u></p> <p><u>(二) モリブデン若しくはルテニウム又はモリブデンとルテニウムを組み合わせた膜を原子層堆積法により成膜するように設計又は改造した装置であって、次の全てに該当するもの(ネに該当するものを除く。)</u></p> <p><u>1 七五度を超える温度で動作するように設計又は改造した金属前駆体の供給源を有するもの</u></p> <p><u>2 四キロパスカル以上の圧力で水素を含む還元剤を使用するプロセスチャンバーを有するもの</u></p> <p><u>(三) プラズマ又はラジカルを用いた化学的気相成長法により成膜するように設計した装置であって、基板の温度を五〇〇度未満に維持しながら、誘電体膜を単一の装置上で紫外線による硬化を行うもののうち、次の全てに該当する誘電体膜を成膜できるもの</u></p> <p><u>1 六ナノメートル超二〇ナノメートル未満の厚さの金属形状であって、二四ナノメートル未満のピッチを有し、かつ、一・八以上のアスペクト比を有するもの</u></p> <p><u>2 三・〇未満の比誘電率を有するもの</u></p> <p><u>(四) 炭素材料を化学的気相成長法により成膜するように設計した装置であって、密度が一立方センチメートル当たり一・六グラムを超える材料を用いたもの(キに該当するものを除く。)</u></p> <p><u>(五) 二種類以上の金属前駆体を直接液体注入する成膜装置であって、単一の成膜用のチャンバー内に、幅に対する深さの比率が五〇倍を超える形状に、比誘電率が三五を超える等方的誘電体膜を成膜するように設計又は改造したもの</u></p>	<p><u>「貨物等省令第6条第十七号キ(二)I中の金属前駆体の供給源」</u></p> <p><u>装置と一体化されていないものを含む。</u></p>

2-33 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「アニール装置」の追加【規制の強化】

・レーザーなどを用いて熱処理をする「アニール装置」を追加

- 輸出令別表第1 7の項(16)
- 貨物等省令 第6条 第17号 ユ
- 運用通達 1-1(7)(イ) (解釈の表) 7の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p><u>ユ 三〇〇ミリメートルウエハー用に設計したアニール装置であって、ウエハーを一、〇〇〇度を超える温度で、二ミリ秒未満の持続時間で加熱できるように設計したもの</u></p>	<p><u>「貨物等省令第6条第十七号ユ中の持続時間」</u></p> <p><u>ウエハーの温度が1,000度超である時間の範囲をいう。</u></p>

2-34 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「超臨界二酸化炭素洗浄装置」の追加【規制の強化】

・ 「超臨界二酸化炭素洗浄装置」を追加

● 輸出令別表第1 7の項(16)

● **貨物等省令** 第6条 第17号 メ

輸出令	貨物等省令	運用通達
【7の項】 (16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品	第六条 (略) 十七 (略) <u>メ 超臨界二酸化炭素又は昇華乾燥を用いるように設計した枚葉式のウエハー洗浄装置</u>	

2-35 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「ウエハー欠陥検査装置」の追加【規制の強化】

・ 「ウエハー欠陥検査装置」を追加

- 輸出令別表第1 7の項(16)
- **貨物等省令** 第6条 第17号 ミ
- **運用通達** 1-1(7)(イ) (解釈の表) 7の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16) 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p><u>ミ 直径三〇〇ミリメートル以上のウエハーを受け入れるように設計又は改造したパターン付きウエハー欠陥測定装置又はパターン付きウエハー欠陥検査装置であって、次の全てに該当するもの</u></p> <p><u>(一) ニーナノメートル以下の大きさの欠陥を検出するように設計又は改造したものの</u></p> <p><u>(二) 次のいずれかを有するもの</u></p> <p><u>1 波長が四〇〇ナノメートル未満の光源</u></p> <p><u>2 分解能が一・六五ナノメートル以下の電子ビーム源</u></p> <p><u>3 ビーム冷陰極電界放出型の電子ビーム源</u></p> <p><u>4 ニ以上の電子ビーム源</u></p>	<p><u>「貨物等省令第6条第十七号ミ(二)1中の光源」検査に用いられる光源をいう。</u></p> <p><u>レーザー光を波長変換するために設計したセシウムリチウムボレート(CLBO)から加工された光学素子を含む。</u></p> <p><u>「貨物等省令第6条第十七号ミ(二)2中分解能」ウエハー上での電子線の分解能をいう。</u></p> <p><u>「貨物等省令第6条第十七号ミ(二)4中の「ニ以上の電子ビーム源」電子ビーム源が2以上存在するものをいう。</u></p>

2-36 輸出令(別表第1) 7の項(16):エレクトロニクス

■ 「重ね合わせ精度計測装置」の追加【規制の強化】

- ・ 「重ね合わせ精度計測装置」を追加
- 輸出令別表第1 7の項(16)
- 貨物等省令 第6条 第17号 シ
- 運用通達 1-1(7)(イ)(解釈の表)7の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(16)半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品</p>	<p>第六条 (略)</p> <p>十七 (略)</p> <p><u>シ 計測装置であって、次のいずれかに該当するもの</u></p> <p><u>(一) 露光前にウエハー形状パラメータを測定し、開口数一・三超の液浸レンズを有する深紫外リソグラフィ装置又は極端紫外リソグラフィ装置の重ね合わせ誤差又はフォーカスを改善するために測定値を利用するように設計したスタンドアロン装置</u></p> <p><u>(二) 画像ベースの重ね合わせ誤差又は回折ベースの測定技術を用いて、製品ウエハー上のレジスト現像後又はエッチング後のフォーカス又は重ね合わせ誤差を測定するように設計した測定装置で、〇・五ナノメートル以下の重ね合わせ誤差測定精度を有するものであって次のいずれかを有するもの</u></p> <p><u>1 トラックへの組み込み用に設計されたもの</u></p> <p><u>2 高速波長切り替え機能を有するもの</u></p>	<p><u>「貨物等省令第6条第十七号シ(ニ)1中のトラック」</u></p> <p><u>リソグラフィ用に調合されたレジストを塗布し、成膜し、加熱し、又は現像するために設計した装置をいう。</u></p> <p><u>「貨物等省令第6条第十七号シ(ニ)2中の高速波長切り替え機能」</u></p> <p><u>25ミリ秒未満で測定波長を変更し測定値を取得する機能をいう。</u></p>

2-37 輸出令(別表第1) 7の項(17):エレクトロニクス

■ 「EUVマスク」等の追加【規制の強化】

「EUVマスク・レチクル」を追加

- 輸出令別表第1 7の項(17)
- **貨物等省令** 第6条 第17号の3
- **運用通達** 1-1(7)(イ)(解釈の表)7の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【7の項】</p> <p>(17)マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品(10の項の中欄に掲げるものを除く。)</p>	<p>第六条 (略)</p> <p><u>十七の三 集積回路の製造用のマスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するもの</u></p> <p>イ～ハ(略)</p> <p><u>ニ 極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用に特に設計したマスク又はレチクルであって、次号に該当するマスクブランクを有するもの又はこれらの部分品若しくは附属品(ホに掲げるものを除く。)</u></p>	<p><u>「貨物等省令第6条第十七号の三ニに該当するマスク又はレチクル」</u></p> <p><u>ペリクルを装着したマスク又はレチクルを含む。</u></p>

2-38 輸出令(別表第1)7の項(18)(24)(25):エレクトロニクス

■ 「シリコン・ゲルマニウム基板」等の追加【規制の強化】

「同位体分離シリコン・ゲルマニウム基板又は原料」を追加

- 輸出令別表第1 7の項(24)(25)
- **貨物等省令** 第6条第18号の2、第25号、第26号

輸出令	貨物等省令	運用通達
【7の項】 (18)半導体基板	<p>第六条(略)</p> <p><u>十八の二 基板であって、当該基板の上に次のいずれかに該当する物質の一層以上からなる膜の結晶を有し、かつ、当該結晶がエピタキシャル成長されているもののうち、エピタキシャル材料となるもの</u></p> <p><u>イ シリコンであって、シリコンニハ又はシリコン三〇以外のシリコンの同位体からなる不純物の割合が〇・〇八パーセント未満のもの</u></p> <p><u>ロ ゲルマニウムであって、ゲルマニウム七〇、ゲルマニウム七二、ゲルマニウム七四又はゲルマニウム七六以外のゲルマニウムの同位体からなる不純物の割合が〇・〇八パーセント未満のもの</u></p>	
<u>(24)シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物</u>	<p><u>二十五 シリコン又はゲルマニウムのふっ化物、水素化物又は塩化物であって、次のいずれかを含むもの</u></p> <p><u>イ シリコンであって、シリコンニハ又はシリコン三〇以外のシリコンの同位体からなる不純物の割合が〇・〇八パーセント未満のもの</u></p> <p><u>ロ ゲルマニウムであって、ゲルマニウム七〇、ゲルマニウム七二、ゲルマニウム七四又はゲルマニウム七六以外のゲルマニウムの同位体からなる不純物の割合が〇・〇八パーセント未満のもの</u></p>	
<u>(25)シリコン、シリコンの酸化物、ゲルマニウム若しくはゲルマニウムの酸化物又はこれらの基板((18)及び(23)に掲げるものを除く。)若しくはインゴット、ブールその他のプリフォーム</u>	<p><u>二十六 シリコン、シリコン酸化物、ゲルマニウム又はゲルマニウム酸化物であって、次のいずれかを含むもの又はこれらの基板若しくはインゴット、ブール又はその他のプリフォーム</u></p> <p><u>イ シリコンであって、シリコンニハ又はシリコン三〇以外のシリコンの同位体からなる不純物の割合が〇・〇八パーセント未満のもの</u></p> <p><u>ロ ゲルマニウムであって、ゲルマニウム七〇、ゲルマニウム七二、ゲルマニウム七四又はゲルマニウム七六以外のゲルマニウムの同位体からなる不純物の割合が〇・〇八パーセント未満のもの</u></p>	

2-39 輸出令(別表第1) 8の項:コンピュータ

■ 「デジタル電子計算機」に解釈の改正【規定の明確化】

デジタル電子計算機に係る解釈につき、「部分品→電子組立品」と改正

● 運用通達 1-1(7)(イ) (解釈の表) 8の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【8の項】 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの</p>	<p>第七条 (略)</p> <p>三 デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であつて、次のロ、ハ若しくはトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。)</p> <p>イ 削除</p> <p>ロ デジタル電子計算機であつて、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの</p> <p>ハ デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であつて、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの(最大性能が七〇実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。)</p> <p>ニ～ヘ (略)</p> <p>ト デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した、デジタル電子計算機の附属装置であつて、転送されるデータの転送速度が二・〇ギガバイト毎秒を超えるもの</p> <p>チ～ヌ (略)</p>	<p>「加重最高性能」 加重最高性能(APP)は、64ビット以上の浮動小数点加算と乗算を実行するデジタル電子計算機に適用される加重された最高性能である。 算出方法で使用する略語を次に示す。 (略) APPは、1秒間に実行される浮動小数点演算を1兆回単位に示したものに加重係数を乗じたもの(WT:Weighted TeraFLOPS)として示される。 APPの算出方法の概要は、次の通り。 1～3 (略) 4 ベクトルプロセッサに対しては$W_i=0.9$、非ベクトルプロセッサに対しては$W_i=0.3$とする。 注1～注5 (略) 注6 集合体で性能を向上するように特別に設計されたものであつて、同時動作が可能であり、かつ、記憶装置を共有するプロセッサを含むプロセッサの組合せについては、APPを算出しなければならない。 注 1) (略) 2) プロセッサの組合せが記憶装置を共有するとは、任意のプロセッサが、いかなるソフトウェアの機構の関与なしに、キャッシュラインやメモリワードでのハードウェア伝送を介してシステム内の任意のメモリロケーションにアクセス可能な時をいう。なお、貨物等省令第7条第三号ハに該当するデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品部分品を使用することにより実現するものを含む。 注7 (略)</p> <p>「貨物等省令第7条第三号中のデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品部分品」 データの処理能力を向上させるために増設するものであつて、計算要素を実装できるように設計されたものをいう。装置に組み込まれていない状態で出荷され、その接続がプログラムで制御される電子組立品部分品に限り、貨物等省令第7条第三号ハが適用される。</p>

2-40 輸出令(別表第1)8の項:コンピュータ

■ 「先端ICチップを有する電子計算機」等の追加【規制の強化】

「先端ICチップを有する電子計算機又はその組立品・部分品」を追加

- **貨物等省令** 第7条 第7号
- **運用通達** 1-1(7)(イ) (解釈の表) 8の項

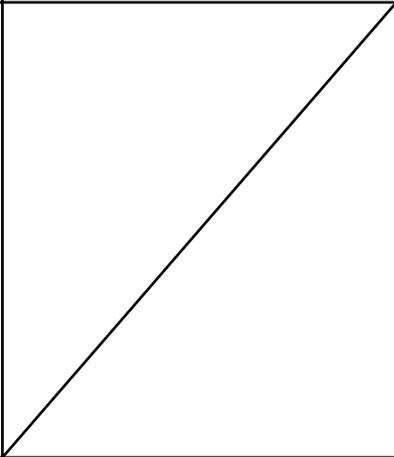
輸出令	貨物等省令	役務通達
【8の項】 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの	第七条(略) <u>七 電子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であつて、前条第一号ヨに該当する集積回路を一つ以上有するもの</u>	<u>「貨物等省令第7条第七号中の電子計算機」</u> デジタル電子計算機、ハイブリッドコンピュータ及びアナログコンピュータを含む。

2-41 外為令(別表) 8の項(1):コンピュータ

■ 「先端ICチップを有する電子計算機等」に係る技術の追加【規制の強化】

「先端ICチップを有する電子計算機等」に係る技術を追加

- 外為令別表 8の項(1)
- 貨物等省令 第20条

外為令	貨物等省令	役務通達
<p>【8の項】</p> <p>(1) 輸出貿易管理令別表第一の8の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)</p>	<p>第二十条 外為令別表の八の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係る技術(プログラムを除く。)を除く。)とする。</p> <p>一 第七条第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)</p> <p>二 第七条第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)</p> <p>三・四 (略)</p>	

2-42 輸出令(別表第1) 9の項(7):通信

「スマートカード」等の仕様の改正【規定の明確化】

「スマートカード・リーダライタ」に係る規定の明確化等

- **貨物等省令 第8条 第9号**
- **運用通達 1-1(7)(イ) (解釈の表) 9の項**

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【9の項】</p> <p>(7) 暗号装置又はその部分品</p>	<p>第八条 (略)</p> <p>九 (略)</p> <p>イ 対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム(アルゴリズムの安全性が次の(一)から(六)までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。以下この号において同じ。)を用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもの(当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されているものを含む。)又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるものに限る。)のうち、次の(七)から(十)までのいずれかに該当するもの(十一)から(十八)までに該当するものを除く。)</p> <p>(十一) 暗号機能を有するスマートカード若しくはそのリーダライタであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品</p> <p>1 スマートカードであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>一 データ機密性確保のための暗号機能が、本号イに該当しない装置又はシステム(本号へにのみ該当するものを除く。)に限定して使用されるスマートカードであって、かつ、他の用途のためにプログラムの書き換えができないもの 次のいずれかに該当するものに限定されて使用されるものであって、他の用途のためにプログラムの書き換えを行うことができないもの イ(七)から(十)までのいずれにも該当しないもの ロ 対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズムを用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計したものの以外のもの ハ(十二)から(十六)までに該当するもの</p> <p>二 (略)</p> <p>イ・ロ (略)</p> <p>ハ 当該スマートカードを使用する者が当該スマートカードの有するデータの機密性確保のための暗号機能を変更することができないもの</p> <p>2 リーダライタであって、専らイに該当するスマートカードに記録された個人情報若しくは団体情報に係る情報を読み取り、又は当該スマートカードに個人情報若しくは団体情報に係る情報を記録するように設計し、又は改造したもの(電気通信回線を通じて読み取り、又は記録するものを含む。)</p> <p>(十二) 暗号装置であって、銀行業務若しくは決済(料金の徴収及び精算又は割賦販売法(昭和二十六年法律第百五十九号)第二条第二項に規定する包括信用購入あっせんに係る業務を含む。)に使用するように設計したものの又はその部分品</p>	<p>「データの機密性確保のための暗号機能」 デジタル方式の暗号処理(情報の内容の秘匿又は情報の不正な改ざん若しくは不正な利用の防止を目的として情報の変換(秘匿パラメータを用いた情報の変換に限る。)を行う処理をいう。固定式(符号化又はデータ圧縮のアルゴリズムが外部からのパラメータを受け入れず、かつ、使用者によって変更できないもの)の符号化及びデータ圧縮を除く。)を行うもの(当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能を有効化できるものを含む。))に限る。)のうち、次のイからエ+のいずれかのため以外の暗号機能をいう。</p> <p>イ~ヘ (略)</p> <p>ト 公開された又は商業用の暗号標準のみを用いた無線パーソナルエリアネットワーク機能(任意の数の独立したデジタル情報送受信装置が互いに直接通信することができ、かつ、個人又はデバイスコントローラーが物理的に近接する範囲(一部屋、自動車及びそれらの周辺など)の通信に制限されたデータ通信システムをいう。また、ローカルエリアネットワークは、パーソナルエリアネットワークの範囲を地理的に超えるものをいう。)</p> <p>チ 銀行業務又は決済(料金の徴収若しくは精算又は割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第3項に規定する包括信用購入あっせんに係る業務を含む。)に使用するように設計した暗号機能</p> <p>リ+ イからチ+までのいずれかに該当する機能を支援するための鍵管理機能</p> <p>ヌ 有効化されていない若しくは使用できない暗号機能であって、安全な仕組みの暗号機能有効化の手段によってのみ有効化し、又は使用することができるもの</p>

2-42 輸出令(別表第1) 9の項(7):通信

<続き>

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【9の項】</p> <p>(7) 暗号装置又はその部分品</p>	<p>(十三十三) 民生用に設計したの携帯用電話機端末(携帯回線網用の電話その他の無線回線網用の電話をいう。十四十五)において同じ。)若しくは移動用電話機端末(専ら自動車その他の移動体において使用するように設計したものをいう。十四十五)において同じ。)であって、次の1及び2に該当するもの(衛星電話を除く。)又はこれらの部分品</p> <p>1・2 (略)</p> <p>(十三十四) (略)</p> <p>(十四十五) 民生用に設計したの携帯用電話機端末若しくは移動用電話機端末又は同等の無線機端末であって、公開された又は商業用の暗号標準(無断の複製を防止するためのものであって、公開されていないものを含む。)のみを用いたもののうち、暗号機能が使用者によって変更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもので、かつ、特定の民生産業用途に用いるために設計を変更したもの(暗号機能を変更していないものに限る。)のうち、次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品</p> <p>1 設計を変更する前の端末が、本号へに該当するもの</p> <p>2 設計を変更する前の端末のデータの機密性確保のための暗号機能が、設計の変更による影響を受けないものであって、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもの</p> <p>(十六) 無線パーソナルエリアネットワークに用いられる装置であって、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたもの又はその部分品</p> <p>(十五十七) 民生用に設計した移動体通信用の無線アクセスネットワーク装置であって、暗号機能が使用者によって変更できず、使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計したもののうち、無線周波数の出力が〇・ワット(二〇ディービーエム)以下で、かつ、同時に接続できるデバイスが三二十六以下のもの又はその部分品</p> <p>(十六十八) ルーター、スイッチ、ゲートウェイ若しくはリレーであって、データの機密性確保のための暗号機能情報システムのセキュリティ管理機能が装置の操作、管理若しくは保守に関するものに限定されており、かつ、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたもの又はこれらの部分品</p> <p>(十七十九) 汎用目的の計算機能を有する装置若しくはサーバーであって、データの機密性確保のための暗号機能情報システムのセキュリティ管理機能が次の1及び2に該当するもの又はこれらの部分品</p> <p>1・2 (略)</p> <p>(十八二十) (略)</p> <p>1 次のいずれかに該当するもの</p> <p>一 ネットワークに接続可能な端末であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ データの機密性確保のための暗号機能情報システムのセキュリティ管理機能が、任意でないデータの秘匿又は操作、管理若しくは保守に限定されているもの</p> <p>ロ (略)</p> <p>二 ネットワーク装置であって、次のイ及びロに該当するもの</p> <p>イ (略)</p> <p>ロ データの機密性確保のための暗号機能情報システムのセキュリティ管理機能が、一に該当する端末のネットワークに接続する民生産業用途の支援に限定されているもの、又は当該ネットワーク装置若しくは本号イ(十八二十)に該当する他の貨物の操作、管理若しくは保守に限定されているもの</p> <p>2 データの機密性確保のための暗号機能情報システムのセキュリティ管理機能が、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたものであって、当該貨物の有する暗号機能が当該貨物を使用する者によって変更できないもの</p>	

2-43 輸出令(別表第1) 12の項(2):海洋関連

■ 「船舶用伝動装置」の仕様の改正【規制の緩和】

船舶の部分品である伝動装置の仕様（出力「2メガワット→10メガワット」等）を改正

● 貨物等省令 第11条 第10号

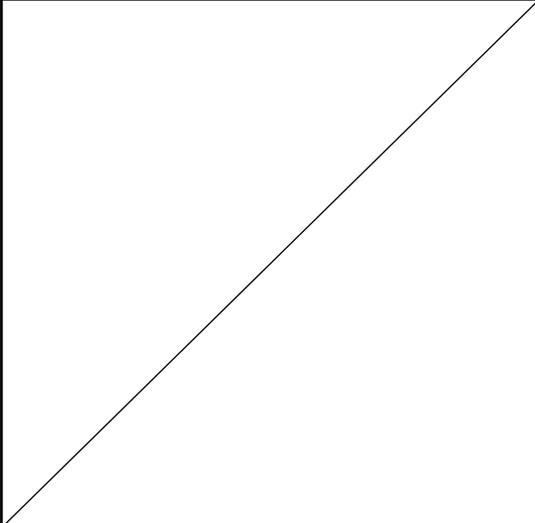
輸出令	貨物等省令	運用通達
【12の項】 (2) 船舶の部分品又は附属装置(1及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)	第十一条(略) 十 船舶の部分品であつて、次のいずれかに該当するもの イ〜ハ(略) ニ 複合材料を用いた軸を組み込んだ伝動軸装置であつて、 土 10メガワットを超える出力を伝達するよう設計したものが できるもの	

2-44 輸出令(別表第1) 13の項(3):推進装置

■ 「極低温用冷却装置」等の仕様の改正【規制の強化】

液体ロケット推進装置の部分品である極低温冷却装置等の仕様（液体損失の割合、温度等）を改正

● 貨物等省令 第12条 第6号

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【13の項】</p> <p>(3) ロケット推進装置又はその部分品</p>	<p>第十二条（略）</p> <p>六 液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>イ 極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低温用装置であって、宇宙空間用の飛しょう体又はその打上げ用の飛しょう体に使用するように設計し、かつ、極低温状態にある液体の損失が一年間につき三〇％未満となるように設計したもののもの</p> <p>ロ 零下七三・一五度以下の温度を維持又は生成するように設計された極低温用容器又は閉サイクル冷却装置</p> <p>であって、零下七三度以下にすることができるもののうち、宇宙空間用の飛しょう体、打上げ用の飛しょう体又はマッハ数が三を超える速度での巡航が可能な航空機に使用することができるように設計したもの</p> <p>ハ～チ（略）</p>	

2-45 輸出令(別表第1) 15の項(5):機微品目

■ 「えい航 hidroホンアレー」の解釈の改正【規定の明確化】

貨物等省令第14条第6号ロ(二)に適用していた解釈を同号ロ(一)にも適用する

● 運用通達 1-1(7)(イ)(解釈の表)15の項

輸出令	貨物等省令	運用通達
<p>【15の項】</p> <p>(5) 音波を利用した水中探知装置又はその部分品</p>	<p>第十四条(略)</p> <p>六 音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの</p> <p>ロ えい航 hidroホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの</p> <p>(一) hidroホングループの間隔(隣接する二の hidroホングループの中心間の距離をいう。以下この号において同じ。)が一・五メートル未満のもの又は一・五メートル未満に変更できるもの</p> <p>(二) 三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したものの又は改造できるもの</p> <p>(三) ~ (ハ) (略)</p>	<p><u>「貨物等省令第14条第六号ロ(一)中の変更できるもの」</u></p> <p><u>配線の数の10パーセントを超えるスペア配線、hidroホングループの間隔を調整するためのブロック、又は水深を制限する内蔵装置であって、調整可能なもの若しくは2以上の hidroホングループを制御するものを有することをいう。</u></p> <p>「貨物等省令第14条第六号ロ(二)中の改造できるもの」</p> <p><u>「貨物等省令第14条第六号ロ(一)中の変更できるもの」の解釈に同じ。</u></p> <p><u>配線の数の10パーセントを超えるスペア配線、hidroホングループの間隔を調整するためのブロック、又は水深を制限する内蔵装置であって、調整可能なもの若しくは2以上の hidroホングループを制御するものを有することをいう。</u></p>